

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2020년 10월 22일 (22.10.2020) WIPO | PCT



(10) 국제공개번호
WO 2020/213847 A1

- (51) 국제특허분류:
H01L 21/02 (2006.01) H01L 21/324 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2020/004075
- (22) 국제출원일: 2020년 3월 25일 (25.03.2020)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2019-0045602 2019년 4월 18일 (18.04.2019) KR
- (71) 출원인: 주식회사 티씨케이 (TOKAI CARBON KOREA CO., LTD) [KR/KR]; 17602 경기도 안성시 미양면 개정산업단지 71, Gyeonggi-do (KR).
- (72) 발명자: 이상철 (LEE, Sang Chul); 17602 경기도 안성시 미양면 개정산업단지 71, Gyeonggi-do (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 무한 (MUHANN PATENT & LAW FIRM); 06144 서울시 강남구 언주로 560, 8층, Seoul (KR).

ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

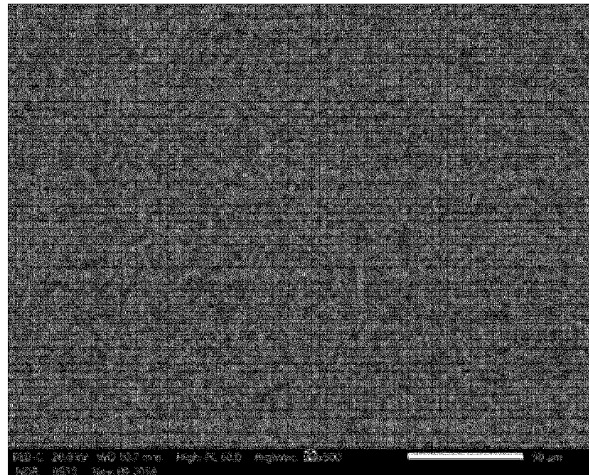
공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU,

(54) Title: SiC MATERIAL AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 발명의 명칭: SiC 소재 및 이의 제조방법



(57) Abstract: The present invention relates to an SiC material and a method for manufacturing same and, more particularly, to an SiC material and a method for manufacturing same, wherein the SiC material includes an SiC layer having a low thermal conductivity region formed in at least a portion thereof, wherein the low thermal conductivity region has an average crystal grain size of 3.5 μm or less and (111) plane preferential growth according to X-ray diffraction analysis.

(57) 요약서: 본 발명은, SiC 소재 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 평균 결정립 크기가 3.5 μm 이하이고, X선 회절 분석에서 (111) 면 우선 성장인 저열전도도 영역; 이 적어도 일부분에 형성된 SiC 층을 포함하는, SiC 소재 및 이의 제조방법에 관한 것이다.



WO 2020/213847 A1